

2Т306А

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные структуры n-p-n переключательные и усилительные с ненормированным коэффициентом шума.

Предназначены для применения в усилителях высокой частоты (2Т306В, 2Т306Г, КТ306В, КТ306Г, КТ306Д) и переключающих устройствах (2Т306А, 2Т306Б, КТ306А, КТ306Б).

Транзисторы выпускаются в металlostеклянном корпусе с гибкими выводами.

Тип приборов указывается на корпусе.

Масса транзистора не более 0,65 г.

Тип корпуса: КТЮ-3-1.

Технические условия: СБ0.336.015 ТУ.

Основные технические характеристики транзистора 2Т306А:

- Структура транзистора: n-p-n
- $P_{к\max}$ - Постоянная рассеиваемая мощность коллектора: 150 мВт;
- $f_{гр}$ - Граничная частота коэффициента передачи тока транзистора для схемы с общим эмиттером: не менее 300 МГц;
- $U_{кб0\max}$ - Максимальное напряжение коллектор-база при заданном обратном токе коллектора и разомкнутой цепи эмиттера: 15 В;
- $U_{эб0\max}$ - Максимальное напряжение эмиттер-база при заданном обратном токе эмиттера и разомкнутой цепи коллектора: 4 В;
- $I_{к\max}$ - Максимально допустимый постоянный ток коллектора: 30 мА;
- $I_{кб0}$ - Обратный ток коллектора - ток через коллекторный переход при заданном обратном напряжении коллектор-база и разомкнутом выводе эмиттера: не более 0,5 мкА;
- $h_{21Э}$ - Статический коэффициент передачи тока для схемы с общим эмиттером в режиме большого сигнала: 20...60;
- $C_{к}$ - Емкость коллекторного перехода: не более 5 пФ;
- $R_{кэ\text{нас}}$ - Сопротивление насыщения между коллектором и эмиттером: не более 30 Ом

Технические характеристики транзисторов 2Т306А, 2Т306Б, 2Т306В, 2Т306Г:

Тип транзистора	Структура	Предельные значения параметров при $T_{п}=25^{\circ}\text{C}$						Значения параметров при $T_{п}=25^{\circ}\text{C}$							$T_{п\max}$ °C	T_{\max} °C
		$I_{к\max}$	$I_{к.и.\max}$	$U_{кэR\max}$	$U_{кб0\max}$	$U_{эб0\max}$	$P_{к\max}$	$h_{21Э}$	$U_{кэ\text{нас}}$	$I_{кб0}$	$f_{гр}$	$C_{ш}$	$C_{к}$	$C_{э}$		
		мА	мА	В	В	В	мВт		В	мкА	МГц	дБ	пФ	пФ		
2Т306А	n-p-n	30	50	10	15	4	150	20...60	0,3	0,5	300	8	5	4,5	150	-60...+125
2Т306Б	n-p-n	30	50	10	15	4	150	40...120	0,3	0,5	500	8	5	4,5	150	-60...+125
2Т306В	n-p-n	30	50	10	15	4	150	20...100	0,3	0,5	300	8	5	4,5	150	-60...+125

																25
2Т306Г	n-p-n	30	50	10	15	4	15 0	40...2 00	0,3	0,5	500	8	5	4, 5	15 0	- 60...+1 25

Условные обозначения электрических параметров транзисторов:

- **$I_k \max$** - максимально допустимый постоянный ток коллектора транзистора.
- **$I_k \text{ и. } \max$** - максимально допустимый импульсный ток коллектора транзистора.
- **$U_{кЭR \max}$** - максимальное напряжение между коллектором и эмиттером при заданном токе коллектора и сопротивлении в цепи база-эмиттер.
- **$U_{кЭ0 \max}$** - максимальное напряжение между коллектором и эмиттером транзистора при заданном токе коллектора и токе базы, равным нулю.
- **$U_{кБ0 \max}$** - максимальное напряжение коллектор-база при заданном токе коллектора и токе эмиттера, равным нулю.
- **$U_{ЭБ0 \max}$** - максимально допустимое постоянное напряжение эмиттер-база при токе коллектора, равном нулю.
- **$P_k \max$** - максимально допустимая постоянная мощность, рассеиваемая на коллекторе транзистора.
- **$h_{21Э}$** - статический коэффициент передачи тока биполярного транзистора.
- **$h_{21э}$** - коэффициент передачи тока биполярного транзистора в режиме малого сигнала в схеме с общим эмиттером.
- **$U_{кэ \text{ нас.}}$** - напряжение насыщения между коллектором и эмиттером транзистора.
- **$I_{кб0}$** - обратный ток коллектора. Ток через коллекторный переход при заданном обратном напряжении коллектор-база и разомкнутом выводе эмиттера.
- **$f_{гр}$** - граничная частота коэффициента передачи тока.
- **$K_{ш}$** - коэффициент шума транзистора.
- **$C_{кк}$** - емкость коллекторного перехода.
- **$C_{ээ}$** - емкость коллекторного перехода.
- **$T_{п \max}$** - максимально допустимая температура перехода.
- **$T \max$** - максимально допустимая температура окружающей среды.